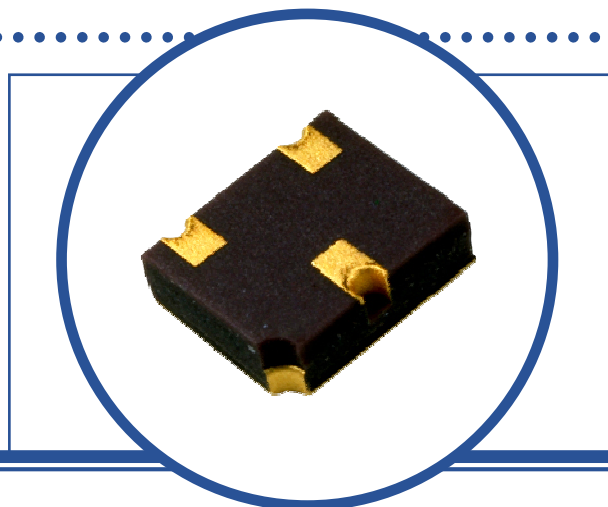


SILICON PLANAR EPITAXIAL NPN TRANSISTOR

2N3114CSM

- High Voltage
- Hermetic Ceramic Surface Mount Package
- Designed For Low Noise General Purpose Amplifiers, Driver Stages and Signal Processing Applications
- Screening Options Available



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

V_{CB0}	Collector – Base Voltage	150V
V_{CE0}	Collector – Emitter Voltage	150V
V_{EB0}	Emitter – Base Voltage	5V
I_C	Continuous Collector Current	150mA
P_D	Total Power Dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate Above 25°C	350mW 2mW/ $^\circ\text{C}$
T_J	Junction Temperature Range	-65 to $+200^\circ\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature Range	-65 to $+200^\circ\text{C}$

THERMAL PROPERTIES

Symbols	Parameters	Min.	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction To Ambient			500	$^\circ\text{C/W}$

Semelab Limited reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.



SILICON PLANAR EPITAXIAL NPN TRANSISTOR 2N3114CSM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

Symbols	Parameters	Test Conditions	Min.	Typ	Max.	Units
I_{CEO}	Collector-Cut-Off Current	$V_{CE} = 150\text{V}$ $I_B = 0$			100	μA
I_{CBO}	Collector-Cut-Off Current	$V_{CB} = 150\text{V}$ $I_E = 0$			10	μA
		$V_{CB} = 100\text{V}$ $I_E = 0$ $T_A = 150^\circ\text{C}$			10	μA
I_{EBO}	Emitter-Cut-Off Current	$V_{EB} = 5\text{V}$ $I_C = 0$			1.0	μA
		$V_{EB} = 4\text{V}$ $I_C = 0$			100	nA
$h_{FE}^{(1)}$	Forward-current transfer ratio	$I_C = 0.1\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}$	15	35		
		$I_C = 30\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}$ $T_A = 150^\circ\text{C}$	30	60	120	
$V_{CE(sat)}^{(1)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 50\text{mA}$ $I_B = 5\text{mA}$			1.0	V
$V_{BE(sat)}^{(1)}$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 50\text{mA}$ $I_B = 5\text{mA}$			0.9	

DYNAMIC CHARACTERISTICS

$ h_{fe} $	Small signal forward-current transfer ratio	$I_C = 30\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}$ $f = 20\text{MHz}$	2			
C_{obo}	Output Capacitance	$V_{CB} = 20\text{V}$ $I_E = 0$ $f = 1.0\text{MHz}$			9	pF
C_{ibo}	Input Capacitance	$V_{EB} = 0.5\text{V}$ $I_C = 0$ $f = 1.0\text{MHz}$			80	pF

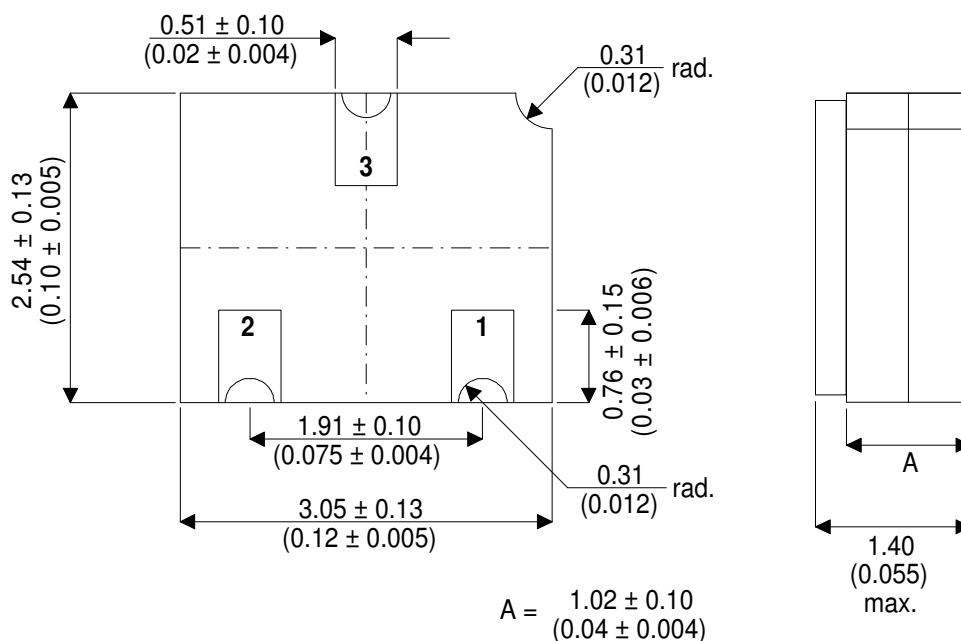
Notes

(1) Pulse Width $\leq 300\mu\text{s}$, $\delta \leq 2\%$

SILICON PLANAR EPITAXIAL NPN TRANSISTOR 2N3114CSM

MECHANICAL DATA

Dimensions in mm (inches)



LCC1

Underside View

Pad 1 - Base

Pad 2 - Emitter

Pad 3 - Collector



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331